

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年9月15日(2005.9.15)

【公開番号】特開2002-294483(P2002-294483A)

【公開日】平成14年10月9日(2002.10.9)

【出願番号】特願2001-322035(P2001-322035)

【国際特許分類第7版】

C 2 5 D 3/38

C 2 5 D 7/12

H 0 1 L 21/288

【F I】

C 2 5 D 3/38

C 2 5 D 7/12

H 0 1 L 21/288 E

【手続補正書】

【提出日】平成17年4月1日(2005.4.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

0.5 μm未満のサイズを有するアパーチャを含有するウェハ上に配置された、実質的に不連続の無い金属シード層を提供する方法であって、該方法が、ウェハ上に配置された不連続性を有する金属シード層を、1以上の銅イオン源、1以上の促進剤、及び酸性電解質を含み、銅イオンが10g/Lまでの量で存在する電気めっき浴と接触させる工程を含む、該方法。

【請求項2】

銅イオンが8g/Lまでの量で存在する、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

電解質が70g/Lまでの添加酸を含む、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

アパーチャが0.18μm以下のサイズを有する、請求項1に記載の方法。

【請求項5】

請求項1に記載の方法に従って調製された金属シード層を有するウェハを提供する工程を含む、集積回路を製造する方法。